

パワーランジスタ

2SD856, 2SD856A

2SD856, 2SD856A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

電力増幅用 / Power Amplifier

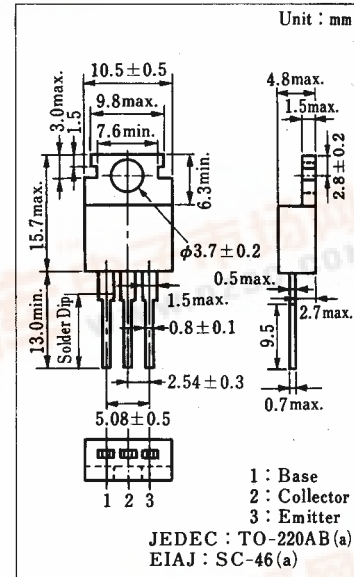
2SB761, 2SB761A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SB761, 2SB761A

■ 特徴 / Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きく、直線性がよい。 / High h_{FE} and good linearity
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
		80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	5	A
コレクタ電流	I_C	3	A
コレクタ損失 (Tc=25°C)	P_C	35	W
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Tc=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	I_{CES}	$V_{CE}=60V, V_{BE}=0$			200	μA
		$V_{CE}=80V, V_{BE}=0$			200	
コレクタ しゃ断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=30V, I_B=0$			300	μA
		$V_{CE}=60V, I_B=0$			300	
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=6V, I_C=0$			1	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=30mA, I_B=0$	60			V
			80			
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE}=4V, I_C=1A$	40		250	
	h_{FE2}	$V_{CE}=4V, I_C=3A$	10			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=4V, I_C=3A$			1.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3A, I_B=0.375A$			1.2	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=1A, I_{B1}=0.1A, I_{B2}=-0.1A$		0.5		μs
ターンオフ時間	t_{off}			3		μs

* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE1}	40~90	70~150	120~250

